
	<p><b>SIR638DP-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIR638DP-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 40V 100A PPAK SO-8</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.SIR638DP-T1-GE3.pdf</a> <a href="#">2.SIR638DP-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 286 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIR638DP-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 100A PPAK SO-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	286 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.3V @ 250µA
Vgs (Max)	+20V, -16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	0.88 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	104W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	10500pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	204nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

SIR638DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIR638DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIR638DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIR638DP-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIR640ADP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SIR632DP-T1-RE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 150V 29A POWERPAKSO</p>	 <p><b>SIR638ADP-T1-GE3</b> VISHAY SIR638ADP-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p><b>SIR640ADP</b> IOR IOR QFN8</p>
 <p><b>SIR638ADP-T1-RE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 100A POWERPAKSO</p>	 <p><b>SIR638ADP-T1-E3</b> VISHAY VISHAY PAKSO-8</p>	 <p><b>SIR640ADP-T1-E3</b> VISHAY VISHAY PAKSO-8</p>	 <p><b>SIR638DP-T1-RE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 100A POWERPAKSO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIR638DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SIR638DP-T1-GE3 Datenblatt	SIR638DP-T1-GE3-Datenblätter	SIR638DP-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIR638DP-T1-GE3
SIR638DP-T1-GE3 Electronic	SIR638DP-T1-GE3-Komponenten	SIR638DP-T1-GE3-Verteiler	SIR638DP-T1-GE3-Bild	SIR638DP-T1-GE3-Teil
SIR638DP-T1-GE3 Preis	SIR638DP-T1-GE3 Hersteller	SIR638DP-T1-GE3 Bild	SIR638DP-T1-GE3 Aktie	SIR638DP-T1-GE3 Inventar
SIR638DP-T1-GE3 Neu	SIR638DP-T1-GE3 Original	SIR638DP-T1-GE3 garantiert	SIR638DP-T1-GE3 RFQ	SIR638DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited